

## PCT/FR03/03323

1 3 JAN, 2004

MAILED 2 6 JAN 2004
WIPO PCT

# BREVET D'INVENTION

#### **CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION**

### **COPIE OFFICIELLE**

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 2 1 NOV. 2003

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Le Chef du Département des brevets

**Martine PLANCHE** 

DOCUMENT DE PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 17.1.a) OU b)

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIETE
INDUSTRIELLE

SIEGE 26 bls, rue de Saint Petersbourg 75800 PARIS cedex 08 Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04 Télécople : 33 (0)1 53 04 45 23 www.lnpl.fr



#### BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



26 bls, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08 Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

#### REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 1/2

elephone : 33 (1) 33 04 33 04 (elecupio : 35 (7) 42 3 04 (elecupio : 35 (7)	Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire DB 540 @ W / 010201
REMISE DESPRICES NOV 2002	NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE
DATE	À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE
ueu 75 INPI PARIS	
N° D'ENREGISTREMENT 0214108	CABINET PLASSERAUD 84 RUE D'AMSTERDAM
NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI	75009 PARIS
DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE 12 NOV. 2	
Vos références pour ce dossier (facultatif) AH/EMA-BFF020324	o a
Confirmation d'un dépôt par télécopie	N° attribué par l'INPI à la télécopie
2 NATURE DE LA DEWANDE	Cochez l'une des 4 cases suivantes
Demande de brevet	K
Demande de certificat d'utilité	
Demande divisionnaire	
Demande de brevet initiale	N° Date
ou demande de certificat d'utilité initiale	N° Date
Transformation d'une demande de	
brevet européen Demande de brevet initiale	N° Date
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou	espaces maximum)
UNE ONDE ET UN OBSTACLE.	RANDEUR PHYSIQUE REPRESENTATIVE D'UNE INTERACTION ENTRE
DÉCLARATION DE PRIORITÉ	Pays ou organisation Date
OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE	Pays ou organisation
LA DATE DE DÉPÔT D'UNE	Date 1 1 1 1 1 N°
DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE	Pays ou organisation
	I Date 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»    X   Personne morale   Personne physique
DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases)	
Nom ou dénomination sociale	CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE - CNRS
Prénoms	Tachnologiaua EDST
Forme juridique	Etablissement Public, Scientifique et Technologique EPST
N° SIREN	
Code APE-NAF	DE SUE ANCE
Domicile Rue	3, RUE MICHEL ANGE
ou Siège Code postal et ville	[7   5   7   9   4   PARIS Cedex 16
Pays	FRANCE
Nationalité	FRANCAISE  N° de télécople (facultatif)
N° de téléphone (facultatif)	14 de relécubre (lacturais)
Adresse électronique (facultatif)	্মি) S'il y a plus d'un demandeur, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»
B .	IN An An hina and an and an



#### BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ



REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 2/2

BR2

REMISE DESPIÈSES NO C	Réservé à l'INPI				
LIEU 75 INPI I	Paris				
	0214108			70 740 5 111 4 310901	
N° O'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'I	NO			D8 540 © Y/ / 010801	
		AH/EMA-BFF02	n324		
Vos références po (facultatif)		AH/EMA-BFF02	0024		
[6] MANDATAIRE	(s'il y a lieu)				
Nom					
Prénom					
Cabinet ou Soc	ciété	CABINET PLASSERAUD			
N °de pouvoir de lien contrac	permanent et/ou ctuel				
	Rue	84 RUE D'AMSTERDAM			
Adresse	Code postal et ville	[7  5  0  0  9 ] P	ARIS		
	Pays	FRANCE			
N° de télépho	ne (facultatif)				
N° de télécop					
Adresse élect	ronique (facultatif)	Control of the contro			
7 INVENTEUR (S)		Les inventeurs sont nécessairement des personnes physiques			
Les demandeurs et les inventeurs sont les mêmes personnes		Oui   Oui   Non : Dans ce cas remplir le formulaire de Désignation d'inventeur(s)			
E RAPPORT D	e recherche	Mon : Dans ce cas rempir le formation de l'indicate de l'entre de l'indicate de l'in			
	Établissement immédia ou établissement différé			46.65	
Palement éc	helonné de la redevance (en deux versements)	Uniquement pour les personnes physiques effectuant elles-mêmes leur propre dépôt  Oui  Non			
RÉDUCTION DU TAUX     DES REDEVANCES		Uniquement pour les personnes physiques  Requise pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition)  Obtenue antérieurement à ce dépôt pour cette invention (joindre une copie de la décision d'admission à l'assistance gratuite ou indiquer sa référence): AG  LLLLL			
Si vous ave	ez utilisé l'imprimé «Suite», e nombre de pages jointes	2 PAGES		VISA DE LA PRÉFECTURE	
SIGNATUR OU DU MA (Nom et q	E DU DEMANDEUR INDATAIRE Halité du signataire) LOISEL (CPI N° 94-0311)	4		OU DE L'INPI	
				and the second second	

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.



26 bis, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08 Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

#### BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



## REQUÊTE EN DÉLIVRANCE

Page suite  $N^{\circ}$  .1./2...



	Réservé à l'INPI				
REMISE DED PÉCE O					
75 INPI F	Paris				
<b>ZCO</b>	0214108	3 ┃			
1° D'ENREGISTREMENT VATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'I		Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire	08 829 © W / 180601		
		AH/EMA - BFF020324			
	ur ce dossier (facultatif)	Pays ou organisation	1		
4 DÉCLARATION		Date			
OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE		Pays ou organisation	ŀ		
LA DATE DE DÉPÔT D'UNE		Date N°			
DEMANDE AN	ITÉRIEURE FRANÇAISE	Pays ou organisation	·		
	,	Date			
DEMANDEUR	(Cochez l'une des 2 cases	Personne morale Personne physique			
Nom		ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE CACHAN	1		
ou dénomination	on sociale		40.		
Prénoms	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Etablissement Public à caractère scientifique, culturel et profes	sionnel		
Forme juridiqu	е	Etablissement Public a caractere scientifique, caracter et pro-			
N° SIREN	<u> </u>		,1		
Code APE-NA	- -	THE PROPERTY AND COM			
Domicile	Rue	61, AVENUE DU PRESIDENT WILSON			
ou		IN A CONFICACHAN	/		
siège	Code postal et ville	19 14 12 13 15 ] CACHAN FRANCE	沃		
	Pays	FRANCAISE			
Nationalité		FRANCAIGE	. 4		
N° de télépho			- A		
N° de télécor			. N.		
Adresse elect	ronique ( <i>facultatif</i> ) R (Cochez l'une des 2 case	si 🗷 Personne morale 🔲 Personne physique	ي يو د الله الله الله الله الله الله الله ال		
	W. Cocher Lane des 2 des	UNIVERSITE PARIS SUD (PARIS 11)			
Nom ou dénomina	tion sociale	ONVERONETYMO			
Prénoms	NOT SOCIAL				
Forme juridic	nue	Etablissement Public à caractère scientifique, culturel et profe	ssionnel		
N° SIREN					
Code APE-N	AF				
		15 RUE GEORGES CLEMENCEAU			
Domicile	Rue				
ou	Code postal et ville	[9 11 14 10 15] ORSAY			
siège	Pays	FRANCE			
Nationalité		FRANCAISE			
N° de téléphone (facultatif)			<del></del>		
<b>4</b>	opie (facultatif)				
	ctronique (facultatif)	WICA DE LA	PRÉFECTURE		
ש עם עס מ		ertrand LOISEL PI N° 94-0311			
Ĭ					



26 bis, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08 Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

#### BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



requête en délivrance

Page suite N°  $\frac{2}{2}$ .../ $\frac{2}{2}$ ...



REMISE DESPIÈCES DATE						
LIEU 75 INPI	Paris					
N° D'ENREGISTREMENT	0214108	3				
NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'	NPI		Cet imprimé est à ren	nplir lisiblement i	l'encre noire	DB 829 ⊕ W / 180601
Vos références po	ur ce dossier (facultatif)	AH/EMA-BFF020	324			
DÉCLARATION		Pays ou organisation		_		l
		Date LILI N°				
	DÉPÔT D'UNE	Pays ou organisation	IIII N	•		
	TÉRIEURE FRANÇAISE	Pays ou organisation	· ·			1
DEIMINDE AIN	I FILL OUT I IS MOUNT	Date	<u> </u>			
E DEMANDEUR	(Cochez l'une des 2 cases)	<b>E</b> Personne mor	ale	Personne	physique	
Nom		UNIVERSITY OF	ARIZONA			
ou dénomination	n sociale					
Prénoms						
Forme juridique	9					
N° SIREN			<u> </u>			
Code APE-NAF						
Domicile	Rue		9 RM 3205 - 1717	E. SPEEDWA	Y BLVD	
ou siège	Code postal et ville	18 15 17 12 11 TU	CSON / ARIZONA			
Siege	Pays	USA				
Nationalitė		AMERICAINE				
Nº de téléphor	ne (facultatif)					
Nº de télécopi	e (facultatif)					
Adresse électr	onique ( <i>fecultatif</i> )				10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -	
5 DEMANDEUR	(Cochez l'une des 2 cases)	Personne mo	ale	Personne	pnysique	
Nom						
ou dénominati	on sociale					
Prénoms						
Forme juridiqu	. <u>.</u>					
N° SIREN						
Code APE-NAI						
Domicile	Rue					
ou siège	Code postal et ville					
Siege	Pays					
Nationalité						
Nº de télépho	ne (facultatif)					
N° de télécop						
Adresse élect	ronique ( <i>facultatif</i> )					ÉEECTION
OU DU MAI		rand LOISEL N° 94-0311	1	<u> [</u> (	VISA DE LA PR OU DE L'II	<b>VPI</b>

#### Procédé pour évaluer une grandeur physique représentative d'une interaction entre une onde et un obstacle

L'invention concerne la modélisation des interactions entre une onde incidente et un obstacle de cette onde, notamment dans le domaine du contrôle non destructif.

La modélisation des interactions entre une onde et un obstacle recevant cette onde, tel qu'une cible placée dans la zone sensible d'un capteur, trouve une application avantageuse en contrôle non destructif.

On connaît un procédé de modélisation dit "par éléments finis" consistant à appliquer un pavage de l'espace tridimensionnel entourant l'obstacle et à évaluer les interactions précitées pour tous les pavés de l'espace.

Les procédés de calcul par "éléments finis" apportent une résolution à un problème posé sous forme d'équations Ils se différentielles partielles. fondent une représentation de l'espace d'étude par un d'éléments finis, à l'intérieur desquels des fonctions d'approximations sont déterminées en termes de valeurs nodales de la grandeur physique recherchée. Le problème physique continu devient donc un problème discret aux éléments finis où les grandeurs nodales sont les nouvelles inconnues. De tels procédés cherchent donc à approcher la solution globale, plutôt que les équations aux dérivées spatiales partielles de départ.

25

5

10

15

20 .

. - . . .

La discrétisation de l'espace pris en compte assure que ce dernier soit entièrement recouvert par des éléments finis (lignes, surfaces ou volumes), cette opération porte le nom de "maillage" dans l'espace bidimensionnel (2D) ou de "pavage" dans l'espace tridimensionnel (3D). Les éléments mis en jeu sont soit rectangulaires ou triangulaires en 2D, soit parallélépipédiques ou tétraédriques en 3D. Ils peuvent être de tailles différentes, répartis uniformément sur la surface ou non.

10

15

30

5

En général, la grandeur physique recherchée, telle qu'un potentiel électrostatique ou une valeur de pression, est connue sur la frontière du domaine. Cette frontière peut être fictive. On y impose des conditions aux limites. Le potentiel est donc inconnu à l'intérieur du même domaine. On définit alors un nœud comme étant un sommet d'un élément. Les inconnues du problème sont donc les valeurs du potentiel en chaque nœud de l'ensemble du domaine.

A titre d'illustration, la figure 6 de l'art antérieur représente un exemple de surface, constituée par deux matériaux M1 et M2, de propriétés électromagnétiques différentes, et maillée par des éléments triangulaires comportant chacun trois nœuds Ai, Bi et Ci. L'ensemble du domaine est délimité par une frontière F.

Une fois le maillage défini, plusieurs approches existent pour transformer la formulation physique du problème en une modélisation discrète aux éléments finis. Si le problème est formulé par des équations différentielles et consiste à minimiser une fonctionnelle, on applique

généralement une méthode variationnelle. Cette transformation aboutit à une formulation matricielle dont la résolution donne les solutions nodales, les solutions aux points non nodaux étant obtenues par interpolation linéaire.

Néanmoins, de tels calculs, en trois dimensions, requièrent des ressources informatiques importantes et génèrent des temps de calcul très longs, en dépit de l'accroissement des performances de logiciels permettant d'implémenter ces calculs.

Certes, les problèmes 2D, souvent simplifiés par des conditions de symétrie avantageuses pour ne modéliser qu'une partie de la géométrie, se résolvent rapidement. Mais il n'en est rien pour les problèmes 3D, qui sont les plus fréquents. La figure 6 montre combien la finesse du maillage, c'est à dire le rapport entre la taille d'un élément et celle du plus petit détail du domaine, fait croître le nombre de nœuds.

En conséquence, la quantité d'équations et d'inconnues augmente proportionnellement, et, de là, le temps de calcul nécessaire à la résolution du problème. Il est important de préciser que la génération du maillage, à savoir la discrétisation de l'espace de travail, et la génération de la liste des nœuds consomme un temps de calcul supérieur à celui nécessaire à la résolution du problème.

30

25

5

10

La présente invention vient améliorer la situation.

Elle propose à cet effet un procédé pour évaluer une grandeur physique associée à une interaction entre une onde et un obstacle, dans une région de l'espace tridimensionnel, dans lequel:

- pluralité une maillage, par détermine, on a) surface dont une partie au de d'échantillons représente la surface d'un obstacle recevant une onde principale et émettant, en réponse, une onde secondaire, et l'on attribue à chaque échantillon de surface au moins une source émettant une onde élémentaire représentant une contribution à ladite onde secondaire,
- b) on forme un système matriciel comportant :

5

10

15

20

25

30

- une matrice d'interaction, inversible, appliquée à une région donnée de l'espace et comportant un nombre de colonnes correspondant à un nombre total de sources,
  - une première matrice colonne dont chaque coefficient est associé à une source et caractérise l'onde élémentaire qu'elle émet,
  - et une seconde matrice colonne, obtenue par une multiplication de la première matrice colonne par la matrice d'interaction et dont les coefficients sont des valeurs d'une grandeur physique représentative de l'onde émise par l'ensemble des sources en ladite région donnée,
  - c) pour estimer les coefficients de la première matrice colonne, on affecte des valeurs de grandeur physique choisies à des points prédéterminés, associés chacun à un échantillon de surface, lesdites valeurs choisies étant rangées dans la seconde matrice colonne, et l'on multiplie

cette seconde matrice colonne par l'inverse de la matrice d'interaction appliquée auxdits points prédéterminés,

d) pour évaluer ladite grandeur physique représentant l'onde émise par l'ensemble des sources dans une région donnée de l'espace tridimensionnel, on applique la matrice d'interaction à ladite région donnée et on multiplie cette matrice d'interaction par la première matrice colonne comportant les coefficients estimés à l'étape c).

5

20

25

30

Ainsi, selon l'un des avantages que procure la présente invention, l'étape de maillage a) ne concerne qu'une ou plusieurs surfaces, tandis que le procédé de modélisation de type "par éléments finis" nécessite un pavage de tout l'espace avoisinant l'obstacle, ce qui permet de réduire, dans la mise en œuvre du procédé selon l'invention, les ressources mémoires et les temps de calcul nécessaires.

Le procédé selon l'invention s'applique aussi bien à une onde principale émise par une source lointaine qu'à une onde principale émise en champ proche.

Avantageusement, pour évaluer une grandeur physique représentative d'une interaction entre un élément rayonnant une onde principale en champ proche et un obstacle recevant cette onde principale,

- à l'étape a), on détermine en outre, par maillage, une pluralité d'échantillons de surface représentant ensemble une surface active de l'élément rayonnant l'onde principale, et l'on attribue à chaque échantillon de la surface active au moins une source émettant une onde



élémentaire représentant une contribution à ladite onde principale,

- on applique les étapes b), c) et d) aux échantillons de la surface active, et
- on évalue ladite grandeur physique représentant l'interaction entre l'élément rayonnant et l'obstacle dans une région donnée de l'espace tridimensionnel, en prenant en compte la contribution, en ladite région donnée, de l'onde principale émise par l'ensemble des sources de la surface active et la contribution de l'onde secondaire émise par l'ensemble des sources de la surface de l'obstacle.
- On entend par les termes "élément rayonnant" aussi bien un émetteur de l'onde principale, tel qu'un générateur d'ondes, qu'un récepteur de l'onde principale, tel qu'un capteur de cette onde.
- Dans un premier mode de réalisation, la grandeur physique 20 à évaluer est une grandeur scalaire et, à l'étape a), on attribue une source unique à chaque échantillon de surface.
- Dans un second mode de réalisation, la grandeur physique à évaluer est une grandeur vectorielle exprimée par ses trois coordonnées dans l'espace tridimensionnel, et on attribue, à l'étape a), trois sources à chaque échantillon de surface.
- Dans une réalisation avantageuse, pour estimer, à l'étape d), la contribution de l'onde secondaire dans la région

donnée de l'espace, les valeurs de grandeur physique choisies à l'étape c) sont fonction d'un coefficient prédéterminé de réflexion et/ou de transmission de l'onde principale par chaque échantillon de surface de l'obstacle.

Ainsi, on comprendra que l'onde secondaire peut aussi bien correspondre à une réflexion de l'onde principale, qu'à une transmission de l'onde principale, ou encore à une diffraction de l'onde principale. Dans cette réalisation avantageuse, l'étape c) correspond finalement à une détermination des conditions aux limites à la surface de l'obstacle, en tant qu'interface entre deux milieux distincts notamment dans une hétérostructure.

Par ailleurs, pour un contrôle non destructif d'une cible formant un obstacle d'une onde principale, on attribue un coefficient de réflexion ou de transmission choisi à tous les points prédéterminés de la surface de la cible, et on compare une simulation obtenue par la mise en œuvre du procédé au sens de l'invention avec une mesure expérimentale. Ainsi, les points de la surface de la cible qui, dans la mesure expérimentale, ne vérifient pas la simulation correspondent à des inhomogénéités ou à des impuretés sur la surface de la cible.

Dans une autre approche, on connaît les propriétés globales de l'obstacle, notamment en transmission et/ou en réflexion. Par la mise en œuvre du procédé de l'invention, on optimise alors la position dans l'espace d'un capteur ou même la forme de ce capteur, pour une application à un

contrôle non destructif, ce capteur étant destiné à analyser une cible formant un obstacle de l'onde principale.

A cet effet, dans une réalisation avantageuse, on compare une pluralité de valeurs de la grandeur physique estimée à l'étape d) du procédé au sens de l'invention, obtenues pour une pluralité de régions de l'espace, pour sélectionner une région candidate pour la disposition d'un élément rayonnant destiné à interagir avec l'obstacle.

Comme indiqué ci-avant, on entend par les termes "élément rayonnant" aussi bien un capteur qu'un générateur de l'onde. On comprendra ainsi que l'optimisation de la position de l'élément rayonnant peut s'appliquer aussi à l'optimisation de la disposition ou de la forme d'un générateur d'ondes. Par exemple, la présente invention trouve encore une application avantageuse à la disposition de haut-parleurs dans un volume fermé, délimité par des obstacles, comme par exemple l'habitacle d'un véhicule automobile.

15

20

25

30

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à l'examen de la description détaillée ciaprès, et des dessins annexés sur lesquels :

- la figure 1A représente schématiquement les surfaces respectives d'un élément rayonnant ER émettant une onde et d'un obstacle OBS recevant cette onde, maillées en vue d'évaluer une grandeur scalaire représentative de l'onde en un point M de l'espace tridimensionnel;

- la figure 1B représente en détail un échantillon de surface dS<sub>i</sub> correspondant à une maille de la figure 1A, ainsi qu'une source S<sub>i</sub> associée à l'échantillon de surface dS<sub>i</sub>;
- la figure 2A représente schématiquement les surfaces respectives d'un élément rayonnant ER émettant une onde et d'un obstacle OBS recevant cette onde, maillées en vue d'évaluer une grandeur vectorielle représentative de l'onde en un point M de l'espace tridimensionnel;
- la figure 2B représente en détail un échantillon de surface dS<sub>i</sub> correspondant à une maille de la figure 2A, ainsi que trois sources associées SA<sub>i</sub>, SB<sub>i</sub> et SC<sub>i</sub>;

15

20

- la figure 2C représente, en vue de face, une surface, maillée dont chaque échantillon de surface comporte trois sources SA<sub>i</sub>, SB<sub>i</sub> et SC<sub>i</sub>, pour l'estimation d'une grandeur vectorielle;
- la figure 3A représente, à titre illustratif, les armatures d'un condensateur, de potentiels électriques respectifs V1 et V2, pour l'estimation d'un potentiel électrique au point M de l'espace tridimensionnel, à chaque échantillon de surface dS<sub>i</sub> de la figure 3A étant associée une unique source S<sub>i</sub>;
- la figure 3B représente, à titre illustratif, les armatures d'un condensateur, de potentiels électriques respectifs V1 et V2, pour l'estimation d'un champ électrique  $\vec{E}(M)$ , au point M de l'espace tridimensionnel, à chaque échantillon de surface  $dS_i$  de la figure 3B étant associée trois sources  $SA_i$ ,  $SB_i$  et  $SC_i$ ;

5

- la figure 4A représente, comme les figures 1A et 2A, une interaction entre un élément rayonnant ER et un une grandeur physique obstacle pour évaluer OBS, (scalaire ou vectorielle) en un point M dans une l'espace délimitée par la surface portion de l'élément rayonnant et la surface de l'obstacle, ce point de l'espace M recevant à la fois l'onde émise par réfléchie par et 1'onde l'élément rayonnant l'obstacle ;
- la figure 4B, complémentaire de la figure 4A, représente une transmission par l'obstacle OBS de l'onde émise par l'élément rayonnant ER, en un point M d'un demi-espace délimité par le plan que forme la surface de l'obstacle OBS;
- la figure 5A représente schématiquement un obstacle OBS, de dimensions finies, avec des sources associées aux échantillons de surface agencées pour estimer une grandeur représentative d'une réflexion de l'onde sur l'obstacle;
- 20 la figure 5B, en complément de la figure 5A, représente schématiquement un obstacle OBS, de dimensions finies, avec les sources associées aux échantillons de surface disposées pour estimer une grandeur représentative de la transmission de l'onde par l'obstacle;
- 25 la figure 5C représente une simulation d'une onde ultrasonore émise par un élément rayonnant ER et se propageant vers un obstacle OBS; et
- la figure 6 représente un maillage de milieux tridimensionnels, pour l'application d'un procédé de calcul par "éléments finis", au sens de l'état de la technique.

On se réfère tout d'abord à la figure 1A, sur laquelle la surface d'un obstacle OBS, recevant une onde, est maillée selon une pluralité d'échantillons de surface  $dS_1$  à  $dS_4$ , conformément à l'étape a) précitée.

5

En se référant à la figure 1B, à chaque échantillon de surface dS<sub>i</sub> est associé un hémisphère HEM<sub>i</sub>, tangent à l'échantillon de surface dSi en un point de contact Pi. Préférentiellement, ce point de contact Pi correspond au 10 sommet de l'hémisphère HEM<sub>i</sub>. Pour l'estimation grandeur physique scalaire au point M (tels potentiel électrostatique, une pression acoustique autre), une source unique Si est associée à l'échantillon ¿ de surface dS<sub>i</sub>. Comme on le verra plus loin, dans le cas  $\frac{1}{2}$ 15 de l'estimation d'une grandeur vectorielle dans un point 🞉 de l'espace M, on affectera plutôt trois sources à chaque 🚡 échantillon de surface dSi.

Préférentiellement, l'hémisphère HEM; est construit comme décrit ci-après. Pendant l'étape de maillage a) précitée, on évalue, d'une part, la surface de l'obstacle OBS et, d'autre part, on choisit un nombre d'échantillons de surface dS; selon la précision souhaitée de l'estimation de la grandeur physique au point M. Ainsi, la surface d'un échantillon dS; est donnée par So/N, où So correspond à la surface totale de l'obstacle et N correspond au nombre choisi d'échantillons de surface dS;.

L'hémisphère  $\text{HEM}_i$  est de même surface que l'échantillon  $dS_i$ . Ainsi, le rayon  $R_i$  de l'hémisphère se déduit de l'expression :

$$2\pi R_i^2 = \frac{S_o}{N}$$

5

10

Chaque maille que représente un échantillon de surface dSi forme une décrit, l'exemple dans présente, correspondant au centre Pi de parallélogramme, parallélogramme. de сe diagonales d'intersection des L'hémisphère HEM; est tangent à l'échantillon de surface  $dS_i$  en ce point  $P_i$ . Bien entendu, les mailles peuvent être de forme différente, triangulaire ou autre. On indique de façon générale que le point Pi correspond au barycentre de la maille.

15

20

On définit ainsi la position de la source  $S_i$  (située au centre de l'hémisphère  $HEM_i$ ). La distance séparant la source  $S_i$  du point de contact  $P_i$  correspond au rayon  $R_i$  de l'hémisphère  $HEM_i$  et la droite qui passe par les points  $P_i$  et  $S_i$  est orthogonale à la maille  $dS_i$ .

25

Dans l'exemple représenté sur la figure 1A, on maille en outre la surface d'un élément rayonnant ER, correspondant par exemple à un générateur d'ondes. A chaque maille de la surface de l'élément rayonnant est associé un échantillon de surface dS'i, comme on le verra plus loin.

Le système matriciel que l'on met en forme à l'étape b) précitée correspond à :

$$\begin{pmatrix} V(M_1) \\ V(M_2) \\ \vdots \\ V(M_N) \end{pmatrix} = F \times \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_N \end{pmatrix}$$
 [1]

où:

5

10

15

20

25

- les coefficients v; (avec j=1,2,...,N) de la première matrice colonne correspondent à des valeurs associées chacune à une source, telle qu'une charge électrique (dans le cas de l'estimation d'un potentiel électrique), ou encore à un flux magnétique (dans le cas de l'estimation d'un potentiel magnétique), (dans encore à une vitesse sonore le d'une pression acoustique l'estimation liée à propagation d'une onde sonore) ;
- les coefficients V(M<sub>i</sub>) (avec i=1,2,...,N) de la seconde. matrice colonne correspondent chacun à une valeur de la grandeur physique (un potentiel électrique ou magnétique ou une pression) à estimer en un point M<sub>i</sub> de l'espace;
  - la matrice d'interaction F comporte des coefficients  $C_{i,j}$  dont l'expression générale est donnée par :

$$C_{i,j}=f(M_iS_j)$$
 [2]

On comprendra ainsi que les coefficients de la matrice F sont des coefficients d'interaction qui dépendent de la distance séparant chaque point de l'espace M<sub>i</sub> d'une source S<sub>i</sub> associée à une maille dS<sub>i</sub>.

Dans le cas de la propagation d'une onde électrique, les coefficients  $c_{i,j}$ ,  $v_j$  et  $V(M_i)$ , respectivement de la matrice d'interaction de la première et de la seconde matrice colonne, sont donnés par :

5

$$C_{i,j} = \frac{1}{2\pi\varepsilon_0 \overline{M_i S_j}}$$

$$v_j = q_j$$
[3]

 $V(M_i) = U_i$ 

où:

- $\varepsilon_0$  est une constante diélectrique,
- $\overline{M_iS_j}$  est une distance mesurée en valeur algébrique,
- 10 q<sub>j</sub> correspond à une charge électrique caractérisant une source S<sub>j</sub>, et
  - $U_{i}$  correspond à un potentiel électrique au point  $M_{i}$ .

Dans le cas de la propagation d'une onde magnétique, 15 l'expression de ces coefficients est la suivante :

$$C_{i,j} = \frac{1}{2\pi\mu_0 \overline{M_i S_j}}$$

$$v_j = \varphi_j$$

$$V(M_i) = \theta_i$$
[4]

où:

20 -  $\mu_0$  correspond à la perméabilité magnétique du milieu où se situe le point  $M_i$ ,

- $\varphi_j$  correspond au flux magnétique associé à la source  $S_j$  ;
- $heta_i$  correspond au potentiel magnétique au point  $exttt{M}_i$ .
- Dans le cadre de la propagation d'une onde ultrasonore, ces coefficients sont donnés par :

$$C_{l,j} = -\frac{i\omega\rho}{2\pi} \frac{\exp(i\vec{k}.\overline{M_l}S_j)}{\overline{M_l}S_j}.dS_j$$

$$v_j = \overrightarrow{v_j}$$
[5]

 $V(M_i) = p_i$ 

- 10 dans laquelle:
  - $-i^2=-1.$

20

- $\omega$  est la pulsation de l'onde sonore ;
- ho est la densité du milieu dans lequel se situe le point  $M_{i}$  ;
- 15 le vecteur  $\vec{v}_j$  correspond à la vitesse sonore issue de la source  $S_j$  ;
  - $\vec{k}$  correspond au vecteur d'onde de l'onde sonore ; et
  - $p_i$  correspond à la pression acoustique générée par la propagation de l'onde ultrasonore au point  $M_i$ .

Dans l'expression des coefficients  $c_{1,j}$ , le terme  $dS_j$  correspond à la surface de l'échantillon associé à la source  $S_j$ . De préférence, le maillage d'une surface au sens de l'étape a) du procédé selon l'invention, est

. u. uupu

surface dS=dS1=dS2=...=dSj.

choisi de sorte que chaque maille comporte une même

On remarque en particulier dans l'expression des coefficients  $c_{1,j}$  qu'ils dépendent du produit scalaire entre le vecteur d'onde et le vecteur  $\overrightarrow{M_lS_j}$ . Ainsi, pour des ondes ultrasonores, on tient compte d'un déphasage entre les chemins qui lient chaque source  $S_j$  à un point de l'espace tridimensionnel M, ce déphasage étant dû à une différence de marche entre les rayons partant de chaque source et arrivant au point M (comme le montre la figure 4A). En particulier, on comprendra que l'angle d'incidence d'un tel rayon est pris en compte dans l'expression des coefficients de la matrice d'interaction F.

15

20

10

5

Bien entendu, dans le cadre de la propagation d'une onde électromagnétique de fréquence élevée, donc de longueur d'onde courte, qui diffère du cadre électrostatique ou magnétostatique ci-avant, on tient compte du terme de propagation  $\exp(i\vec{k}.\vec{r})$  dans l'expression de la matrice d'interaction, par rapport à la géométrie du problème à résoudre, comme dans le cadre de la propagation d'une onde ultrasonore ci-avant (relation [5]).

Ainsi, le système matriciel de l'équation [1] permet d'estimer, à partir d'une matrice d'interaction F et d'un vecteur comportant les valeurs v<sub>j</sub> associées aux sources S<sub>j</sub>, les coefficients d'un vecteur (matrice colonne) comportant les valeurs de grandeur physique V(M<sub>i</sub>) aux

30 points de l'espace Mi.

Pour déterminer les valeurs des sources  $v_j$ , on applique le système matriciel suivant :

$$\begin{pmatrix} V(P_1) \\ V(P_2) \\ \vdots \\ V(P_N) \end{pmatrix} = F \times \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_N \end{pmatrix}$$
 [6]

où:

5

- les coefficients de la matrice d'interaction F s'expriment par avec  $C_{i,j}=f(RS_j)$
- les indices i et j correspondent respectivement à la iême ligne et la jême colonne de la matrice d'interaction F. Cette matrice d'interaction comporte, pour la détermination des valeurs associées aux sources vj, N lignes et N colonnes, en rappelant que N est le nombre total de mailles à la surface de l'obstacle;
  - les points  $P_i$  correspondent au sommet des hémisphères  $HEM_i$  de la figure 1B.

La mise en œuvre de l'étape c) du procédé au sens de la présente invention correspond à calculer une condition aux limites pour les points P<sub>i</sub>, de propriétés connues, comme on le verra plus loin.

Le système matriciel de l'équation [6] devient alors :

$$\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_N \end{pmatrix} = F^{-1} \times \begin{pmatrix} V(P_1) \\ V(P_2) \\ \vdots \\ V(P_N) \end{pmatrix}$$
 [7]

où:

- $F^{-1}$  correspond à l'inverse de la matrice d'interaction F ; et
  - les valeurs  $V(P_i)$  sont prédéterminées, en fonction des conditions aux limites précitées.

On détermine ainsi les valeurs de source  $v_j$ .

10

A partir de l'estimation de ces valeurs de source  $v_i$ , on peut calculer la grandeur physique scalaire en un point M quelconque de l'espace tridimensionnel, à partir de la relation :

15

20

$$V(M) = \sum_{j=1}^{N} f(MS_j) v_j$$
 [8]

Pour obtenir cette expression de la grandeur scalaire V(M), la matrice d'interaction F peut ne comporter qu'une ligne de coefficients  $c_{\rm j}$ , avec :

$$C_j = f(MS_j)$$

mais comporte toujours N colonnes.

25

En se référant à nouveau à la figure 1A, on comprendra que la surface de l'obstacle OBS recevant l'onde qu'émet l'élément rayonnant ER agit, elle-même, comme une surface active ré-émettant une onde secondaire (par exemple par

réflexion). Chaque source  $S_i$  représente une contribution à l'émission de cette onde secondaire.

En outre, pour tenir compte à la fois de la présence de l'onde principale et de la présence de l'onde secondaire au point M, on estime la contribution de l'onde principale et la contribution de l'onde secondaire au point M par le système matriciel:

$$V(M) = F x \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_N \end{pmatrix} + F' x \begin{pmatrix} v'_1 \\ v'_2 \\ \vdots \\ v'_{N'} \end{pmatrix}$$
 [9]

où:

- F' est la matrice d'interaction entre la surface de l'élément rayonnant et le point M ;

- v'<sub>j</sub> (avec j=1,2,3,...,N') est la valeur des sources attribuées à chaque échantillon de surface dS'<sub>j</sub> de l'élément rayonnant, N' étant le nombre total de mailles choisi pour la surface active de l'élément rayonnant ER.

. 20

15

5

10

Les coefficients de la matrice F' sont encore fonction de la distance MS', où S', sont les sources affectées à chaque échantillon de surface dS', de l'élément rayonnant.

25 Selon une caractéristique avantageuse, les valeurs des sources de l'obstacle v<sub>j</sub> sont déterminées en fonction des valeurs des sources de l'élément rayonnant v'<sub>j</sub>, lesquelles

sont elles-mêmes calculées comme on le verra plus loin en référence aux figures 4A, 4B, 5A et 5B.

On se réfère maintenant à la figure 2A, dans laquelle on affecte trois sources à chaque échantillon de surface  $dS_i$ , en vue d'estimer une grandeur physique vectorielle  $\overline{V(M)}$ , en un point M de l'espace tridimensionnel.

En effet, on comprendra que pour estimer la grandeur vectorielle, par ses trois coordonnées dans l'espace x, y et z, le nombre d'équations à résoudre par rapport au système matriciel précédent doit être multiplié par trois. Ainsi, la matrice  $F^{-1}$  de la relation [7] doit comporter trois fois plus de lignes que précédemment. La matrice d'interaction F doit, elle-même, comporter trois fois plus de colonnes que précédemment et, à cet effet, on prévoit avantageusement trois sources par maille lorsqu'il s'agit de déterminer les coordonnées dans l'espace tridimensionnel d'un vecteur  $\overline{V(M)}$ .

20

25

5

10

15

En se référant à la figure 2B, les trois sources SAi, SBi, SCi, attribuées à un échantillon de surface dSi sont de positions respectives déterminées comme on l'indique ciaprès. Telles que représentées sur la figure 2B, les trois coplanaires et le  $SC_i$ sont sources SAi, SB<sub>i</sub>, comportant ces trois sources comporte en outre la base de l'hémisphère HEMi. L'hémisphère HEMi est construit comme indiqué ci-avant (de même surface que la surface de la maille), avec toutefois le centre de l'hémisphère qui correspond ici au barycentre des trois sources  $SA_{\mathbf{i}}$ ,  $SB_{\mathbf{i}}$  et  $SC_{\mathbf{i}}$ .

On entend par "centre de l'hémisphère" le centre du disque qui constitue la base de l'hémisphère.

Les trois sources qui sont attribuées à l'échantillon de surface dS<sub>i</sub> sont disposées aux sommets d'un triangle équilatéral dont le barycentre G<sub>i</sub> correspond au centre de l'hémisphère. De préférence, chaque source SA<sub>i</sub>, SB<sub>i</sub> et SC<sub>i</sub> est disposée sur le milieu d'un rayon R<sub>i</sub> de l'hémisphère. Ainsi, les droites qui relient le barycentre G<sub>i</sub> à chaque source sont écartées angulairement de 120°.

10

25

En se référant à la figure 2C, l'orientation angulaire des triangles que forment les triplets de sources est choisie aléatoirement, d'un échantillon de surface à l'autre. Avantageusement, on évite ainsi des artefacts de surpériodicité, dans l'estimation de la grandeur vectorielle au point M, qui pourraient résulter du choix d'une même orientation angulaire de ces triangles.

En référence avec les différents types d'ondes indiqués précédemment, la grandeur vectorielle  $\vec{V}(M)$  à estimer peut être :

- un champ électrique, dans le cadre de la propagation d'une onde électrique;
- un champ magnétique, dans le cadre de la propagation d'une onde magnétique; et
- 30 une vitesse du son au point M, dans le cadre de la propagation d'ondes ultrasonores.

Pour déterminer les valeurs associées à chaque source  $SA_i$ ,  $SB_i$ ,  $SC_i$ , on met en forme le système matriciel selon la relation suivante :

5

$$\begin{pmatrix} V_{x}(P_{1}) \\ V_{x}(P_{2}) \\ \vdots \\ V_{x}(P_{N}) \\ V_{y}(P_{1}) \\ V_{y}(P_{2}) \\ \vdots \\ V_{y}(P_{N}) \\ V_{z}(P_{1}) \\ V_{z}(P_{1}) \\ V_{z}(P_{2}) \\ \vdots \\ V_{z}(P_{N}) \end{pmatrix} = F_{\bar{V}} \times \begin{pmatrix} vA_{1} \\ vA_{2} \\ \vdots \\ vA_{N} \\ vB_{1} \\ vB_{2} \\ \vdots \\ vB_{N} \\ vC_{1} \\ vC_{2} \\ \vdots \\ vC_{N} \end{pmatrix}$$

$$[11]$$

On remarque, en particulier, que la matrice d'interaction  $F_{ar V}$  est de dimensions 3Nx3N, où N est le nombre total d'échantillons de surface. La matrice d'interaction s'exprime ici par la relation :

$$F_{\vec{V}} = \begin{pmatrix} \frac{N}{N \{C_A^x(i,j) & C_B^x(i,j) & C_C^x(i,j) \\ N\{C_A^y(i,j) & C_B^y(i,j) & C_C^y(i,j) \\ N\{C_A^z(i,j) & C_B^z(i,j) & C_C^z(i,j) \end{pmatrix}$$
[12]

Les coefficients de cette matrice s'expriment par :

$$C_{\sigma}^{u}(i,j) = f_{u}\left[d(P_{i},S\sigma_{i})\right]$$
 [13]

s avec

$$\sigma$$
 = A, B, C

$$i = 1, 2, ..., N$$

$$j = 1, 2, ..., N$$

$$u = x_i y_i z$$
.

et sont encore fonction d'une distance séparant le point de contact  $P_i$  de l'une des sources  $S\sigma_j$  ( $\sigma$  = A, B ou C) d'un triplet associé à un échantillon de surface  $dS_j$ .

Par inversion de la matrice d'interaction  $F_{\bar{V}}$ , on détermine ainsi les valeurs  $v\sigma_j$  associées à chaque source  $S\sigma_j$ , en appliquant des conditions aux limites sur les valeurs du vecteur  $\bar{V}$  aux points  $P_i$ . Ces conditions aux limites imposent une valeur du vecteur  $\bar{V}$ , selon ses trois coordonnées  $V_x(P_i)$ ,  $V_y(P_i)$  et  $V_z(P_i)$ .

20

15

Une fois que ces valeurs de sources  $v\sigma_j$  sont ainsi déterminées, on calcule facilement l'expression du vecteur  $\vec{V}$  en un point quelconque M de l'espace, par la relation :

25 
$$\vec{V}(M) = V_x(M) \vec{x} + V_y(M) \vec{y} + V_z(M) \vec{z}$$

$$V_x(M) = \sum_{j=1,\dots,N} f_x [(d(M,S\sigma_j))] \cdot v\sigma_j$$

$$\sigma = A,B,C$$



$$V_{y}(M) = \sum_{j=1,\dots,N} f_{y} [(d(M,S\sigma_{j}))] \cdot v\sigma_{j}$$

$$\sigma = A,B,C$$

$$V_{z}(M) = \sum_{\substack{j=1,\dots,N\\\sigma=A,B,C}} f_{z} \left[ \left( d\left(M,S\sigma_{j}\right) \right) \right] \cdot v\sigma_{j}$$

10

15

20

 $ar{x}$ ,  $ar{y}$  et  $ar{z}$  correspondent à des vecteurs unitaires portés par les axes x, y et z de l'espace tridimensionnel.

Ainsi, la matrice d'interaction  $F_{\bar{V}}$ , lorsqu'elle est appliquée à un point quelconque M de l'espace, ne comporte finalement que trois lignes associées chacune à une coordonnée de l'espace x, y ou z.

Pour différents types d'ondes, les valeurs des sources  $v\sigma_j$  sont, comme précédemment, une charge électrique pour une onde électrique, un flux magnétique pour une onde magnétique, une vitesse du son pour une onde ultrasonore.

Plus précisément, les coefficients de la matrice d'interaction  $F_{\vec{V}}$  se déterminent à partir des relations [3], [4] et [5] précédentes en précisant toutefois que :

$$\vec{V}(M) = -\overrightarrow{grad}[V(M)]$$
 [15]

V(M) étant la grandeur scalaire calculée précédemment par 25 l'équation [8]. Ainsi, pour l'estimation d'une grandeur vectorielle  $ar{ extsf{V}}$  au point M et pour les types d'onde cités ci-avant à titre d'exemple (électrique, magnétique et ultrasonore), sont matrice d'interaction  $F_{\vec{v}}$ la de coefficients proportionnels carré d'une distance au inversement point M, alors que source du chaque séparant l'estimation d'une grandeur scalaire V en un point M de l'espace, les coefficients de la matrice d'interaction F proportionnels inversement simplement sont distance. Chaque distance implique l'une des sources d'un triplet d'un échantillon de surface et un point M de l'espace. La matrice d'interaction  $F_{ar{\mathbf{v}}}$  comporte alors  $3\cent{N}$ colonnes lorsqu'il s'agit de prendre trois sources par échantillon de surface, alors que la matrice d'interaction F pour l'estimation de la grandeur scalaire ne comportait. que N colonnes puisque seule une source par échantillon de surface était nécessaire.

5

10

15

20

Plus généralement, on attribue une source par échantillon lorsque l'on connaît des conditions aux limites pour une grandeur scalaire et trois sources par échantillon lorsque l'on connaît plutôt des conditions aux limites pour une grandeur vectorielle.

On se réfère maintenant à la figure 3A pour décrire, à titre illustratif, une application du procédé selon l'invention à l'estimation d'un potentiel électrique en un point M de l'espace tridimensionnel, situé entre deux armatures d'un condensateur. Les armatures de ce condensateur sont portées à des potentiels respectifs V1

et V2. La mise en œuvre de l'étape a) consiste d'abord à mailler les surfaces respectives des deux armatures. Dans l'exemple représenté sur la figure 3A, on n'a représenté que deux mailles pour chaque armature, simplement à titre illustratif.

L'application de l'étape b) consiste à mettre en forme le système matriciel impliquant la matrice d'interaction F et le vecteur colonne comportant les valeurs des sources  $S_1$  à  $S_4$ . La multiplication de ces deux matrices permet d'obtenir un vecteur colonne comportant les valeurs du potentiel en un ou plusieurs points M de l'espace.

La mise en œuvre de l'étape c) du procédé selon l'invention consiste à appliquer le système matriciel aux points de contact des hémisphères  $P_1$  à  $P_4$ , de chaque échantillon de surface  $dS_1$  à  $dS_4$ . Il en résulte la relation suivante :

$$\begin{pmatrix} V(P_1) \\ V(P_2) \\ V(P_3) \\ V(P_4) \end{pmatrix} = \frac{1}{2\pi\varepsilon_0} \begin{pmatrix} \frac{1}{P_1S_1} & \frac{1}{P_1S_2} & \frac{1}{P_1S_3} & \frac{1}{P_1S_4} \\ \frac{1}{P_2S_1} & \frac{1}{P_2S_2} & \frac{1}{P_2S_3} & \frac{1}{P_2S_4} \\ \frac{1}{P_3S_1} & \frac{1}{P_3S_{21}} & \frac{1}{P_3S_3} & \frac{1}{P_3S_4} \\ \frac{1}{P_4S_1} & \frac{1}{P_4S_2} & \frac{1}{P_4S_3} & \frac{1}{P_4S_4} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{pmatrix}$$
[16]

avec 
$$V(P_1) = V(P_2) = V_1$$
  
 $V(P_3) = V(P_4) = V_2$   
 $V_1 = q_1, v_2 = q_2, v_3 = q_3, v_4 = q_4$ 

Ici, la condition aux limites impose que la valeur du potentiel aux points de contact  $P_1$  et  $P_2$  correspond au potentiel V1 de la première armature. De même, le potentiel électrique aux points de contact  $P_3$  et  $P_4$  correspond au potentiel électrique de la seconde armature V2. Par inversion de la matrice d'interaction appliquée au point de contact  $P_i$ , on détermine les valeurs des sources  $v_i$  qui correspondent, comme exprimé dans la relation [16], à des charges électriques  $q_i$ .

10

5

Les coefficients de la matrice d'interaction  $\frac{1}{2\pi\epsilon_0 P_i S_j}$  sont parfaitement connus, puisque les positions des sources  $S_j$  et les positions des points de contact  $P_i$  sont déterminées au préalable, comme représenté sur la figure 1B.

15

L'expression du potentiel électrique V(M) au point M entre les deux armatures est finalement donnée par l'expression:

25

$$V(M) = \frac{1}{2\pi\varepsilon_0} \left( \frac{q_1}{MS_1} + \frac{q_2}{MS_2} + \frac{q_3}{MS_3} + \frac{q_4}{MS_4} \right)$$
 [17]

On se réfère maintenant à la figure 3B sur laquelle on a représenté les mêmes armatures que sur la figure 3A, avec sensiblement un même maillage, mais dans le but, ici, d'estimer une grandeur vectorielle correspondant au champ électrique  $\overline{E(M)}$ , au point M de l'espace tridimensionnel.

On peut appliquer les relations [11] à [15] pour estimer la valeur du champ électrique au point M, avec, dans la relation [13]:

$$C_{\sigma}^{u}(i,j) = \left(\frac{1}{2\pi\varepsilon_{0} d^{2}(P_{i},S\sigma_{j})}\right)_{u}$$
 [18]

avec

$$\sigma = A$$
, B, C  
 $u = x$ , y, z  
 $i = 1$ , 2, 3, 4  
 $j = 1$ , 2, 3, 4.

Toutefois, les valeurs du champ électrique au point de contact  $P_i$  restent à déterminer dans la relation [11].

On introduit alors une loi générale prédéterminée du comportement du champ (en réflexion, en transmission, ou autre) au niveau de la surface de l'obstacle (des armatures dans l'exemple du condensateur précité), pour connaître les valeurs des sources Vσ<sub>j</sub>.

20

25

10

Par exemple, si l'onde électrique est totalement réfléchie par la surface d'un obstacle (par exemple l'une des deux armatures), le champ électrique en un point de contact  $P_i$  est normal à la surface  $dS_i$  et ses composantes  $E_x$  et  $E_y$  sont nulles. A titre illustratif, si la surface de l'armature n'était représentée que par un seul échantillon de surface à trois sources, les valeurs de ses sources vA, vB et vC seraient toutes égales entre elles à une même valeur +q.

réflexion de coefficient le contraire, si pratiquement nul à la surface dSi, la composante du champ électrique  $E_z$  au point  $P_i$  est nulle, ce qui correspond bien au cas où le champ est sensiblement tangent à la surface dSi. Ainsi, à titre illustratif, si la surface de l'armature n'était représentée que par un seul échantillon de surface à trois sources, les valeurs de ses sources vA, vB et vC seraient respectivement, par exemple, +q, +q et -2q. Par exemple, dans le cadre de la propagation d'une onde magnétique, si la surface d'un capteur à courants de Foucault (avec une composante normale du champ magnétique nulle) était représentée par un unique échantillon de surface, les flux magnétiques des trois sources associées à cet échantillon de surface seraient  $+\phi$ ,  $+\phi$  et  $-2\phi$ .

5

10

15

20

25

30

On comprend ainsi qu'avec les trois sources par échantillon  $dS_i$ , on peut définir, par exemple en fonction de la pondération de chaque source, une orientation quelconque du champ à la surface de l'obstacle.

Bien entendu, cette démarche suppose que le coefficient de réflexion R d'un obstacle soit connu auparavant. En particulier, il peut être avantageux de comparer une simulation et une mesure expérimentale pour détecter, à la surface d'un obstacle, des inhomogénéités ou des impuretés qui correspondent à des points de la surface de cet obstacle qui ne vérifient pas les valeurs du coefficient de réflexion R imposées à chaque point prédéterminé Pi de l'obstacle.

On peut affecter ainsi une valeur prédéterminée coefficient de réflexion à chaque point Pi de la surface de l'obstacle. A cet effet, on introduit une matrice R qui est représentative du coefficient de réflexion en chaque point Pi. Pour une interaction entre un élément rayonnant un obstacle, on peut ainsi exprimer le système matriciel de la relation [9] autrement, c'est-à-dire en donnant une expression unique de toutes les sources du la fois de l'obstacle et de l'élément système (à rayonnant), comme indiqué ci-après.

Dans ce qui suit, on indique que :

. 10

15

- F(P) est la matrice d'interaction de l'obstacle OBS appliquée aux points  $P_i$  de la surface de l'obstacle OBS;
  - F(P') est la matrice d'interaction de l'obstacle OBS appliquée aux points P'i de la surface de l'élément rayonnant ER;
- - F'(P') correspond à la matrice d'interaction de l'élément rayonnant ER appliquée aux points  $P_i$  de la surface de l'élément rayonnant ER;
- 25  $\vec{v}'$  correspond au vecteur colonne comportant les valeurs des sources S' $_i$  de l'élément rayonnant ER ; et
  - $\bar{v}$  correspond au vecteur colonne comportant les valeurs des sources  $S_i$  de l'obstacle OBS.
- 30 Sur l'obstacle, la contribution de l'onde émise par l'élément rayonnant ER s'exprime par :

$$\vec{\mathbf{V}}'(\mathbf{P}) = \mathbf{F}'(\mathbf{P}) \cdot \vec{\mathbf{v}}' \tag{19}$$

La contribution de l'onde secondaire renvoyée par l'obstacle OBS s'exprime, par définition, par la relation:

5

15

20

25

$$\vec{\mathbf{V}}(\mathbf{P}) = \mathbf{F}(\mathbf{P}) \cdot \vec{\mathbf{v}} \tag{20}$$

Or, dans l'exemple représenté sur la figure 4A, l'onde secondaire correspond simplement à une réflexion de l'onde principale. Ce qui s'exprime par la relation :

$$\vec{\mathbf{V}}(\mathbf{P}) = \mathbf{R} \; \vec{\mathbf{V}}'(\mathbf{P}) \tag{21}$$

où R correspond à une matrice de réflexion dont chaque coefficient représente la contribution à l'émission, par réflexion, de l'onde secondaire, par chaque source  $S_i$  (ou  $S\sigma_i$ , dans le cadre d'une estimation d'une grandeur vectorielle) de l'obstacle OBS.

Des trois relations [19], [20] et [21], on déduit l'expression du vecteur colonne  $\vec{v}$  comportant les valeurs des sources de l'obstacle, à partir du vecteur colonne  $\vec{v}$  comportant les valeurs des sources de l'élément rayonnant, par la relation :

$$\vec{v} = [F(P)]^{-1} \cdot R \cdot [F'(P)] \cdot \vec{v}'$$
 [22]

Par ailleurs, pour une estimation fine des grandeurs scalaires ou vectorielles au point M, notamment pour tenir compte de réflexions multiples, il est avantageux de tenir compte de la contribution du rayonnement par l'obstacle, au niveau de la surface de l'élément rayonnant ER. A cet effet, on tient compte, dans l'estimation des conditions aux limites à la surface de l'élément rayonnant ER (aux points P'i) de la contribution du rayonnement des sources S'i de l'élément rayonnant et de la contribution de l'émission de l'onde secondaire par les sources Si de l'obstacle, par la relation :

5

10

25

$$\vec{V}_{T}(P') = F(P') \vec{v} + F'(P') \vec{v}'$$
 [23]

On peut ainsi ajuster, grâce à la relation [23], les valeurs de sources S'i de l'élément rayonnant ER, en tenant compte de la réflexion de l'obstacle OBS, selon la relation suivante:

20 
$$\vec{V}_T(P') = \{F(P') \cdot [F(P)]^{-1} \cdot R \cdot [F'(P)] + F'(P') \} \cdot \vec{v}'$$
 [10]

Ainsi, on impose simplement des conditions aux limites pour l'élément rayonnant, pour en déduire les valeurs des sources v'i. En pratique, on procèdera préférentiellement comme suit :

- après maillage des surfaces, on détermine la position des points P<sub>i</sub> et P'<sub>i</sub> et des sources S<sub>i</sub> et S'<sub>i</sub>;
- en fonction du type d'onde en jeu, on détermine les coefficients des matrices F(P), F'(P), F(P') et F'(P');

- en fonction d'une loi de réflexion de l'obstacle, on détermine les coefficients de la matrice de réflexion comme dans l'exemple donné plus loin pour une onde ultrasonore;
- 5 en fonction de conditions aux limites sur l'élément rayonnant (dont le comportement est généralement connu pour un problème donné), on détermine les valeurs du vecteur  $\vec{V_T}(P)$  aux points P'i de la surface de l'élément rayonnant et on en déduit les valeurs des sources S'i de l'élément rayonnant par inversion de la relation [10];
  - on en déduit aussi les valeurs des sources  $S_i$  de l'obstacle par application de la relation [22];
  - une fois les valeurs de toutes les sources S<sub>1</sub> et S'<sub>1</sub> déterminées, on peut appliquer le système matriciel donné par la relation [9] à tout point M de l'espace, en appliquant à ce point M les matrices d'interaction F et F' (impliquant la position du point M et les positions des sources respectives S<sub>1</sub> et S'<sub>1</sub>).
- En se référant à nouveau à la figure 4A, on considère que l'obstacle OBS représente simplement une interface entre deux milieux M1 et M2, formant ainsi un dioptre qui peut être plan, tel que représenté dans l'exemple de la figure 4A, mais aussi incurvé ou de forme générale quelconque.
  Les coefficients de réflexion R<sub>i</sub> associés à chaque point P<sub>i</sub> dépendent, dans le cadre de la propagation d'une onde ultrasonore ou électromagnétique de haute fréquence, de l'angle d'incidence β<sub>i</sub> du rayon issu de la source S<sub>i</sub>, au point de l'espace tridimensionnel M.

.15

Pour une onde ultrasonore, l'expression des coefficients de réflexion  $R_{\bf i}$  est donnée par :

$$R_{i} = \frac{\rho_{2}c_{2}\cos\beta_{i} - \rho_{1}c_{1}\left[1 - \frac{c_{2}^{2}}{c_{1}^{2}} + \frac{c_{2}^{2}}{c_{1}^{2}}\cos^{2}\beta_{i}\right]^{1/2}}{\rho_{2}c_{2}\cos\beta_{i} + \rho_{1}c_{1}\left[1 - \frac{c_{2}^{2}}{c_{1}^{2}} + \frac{c_{2}^{2}}{c_{1}^{2}}\cos^{2}\beta_{i}\right]^{1/2}}$$
[24]

où:

5

-  $c_1$  est la vitesse du son dans le milieu  $M_1$  ;

-  $c_2$  est la vitesse du son dans le milieu  $M_2$ ;

-  $ho_1$  est la densité du milieu  $M_1$  ;

10 -  $\rho_2$  est la densité du milieu  $M_2$ .

Dans cette expression [24], le terme  $\cos\beta_i$  peut simplement être estimé en fonction des coordonnées dans l'espace du point M et du point représentant la source  $S_i$ .

figure 4B, référant maintenant à la 15 En estimation peut être menée pour un point M situé dans le milieu  $M_2$ . Dans ce cas, l'onde que reçoit le point M est une onde transmise par l'obstacle OBS. En particulier, on remarque que les sources de l'élément rayonnant ER ne sont actives, du fait de l'occultation de l'élément 20 En transmission, rayonnant ER par l'obstacle OBS. précédemment une s'applique comme raisonnement condition aux limites imposée aux points Pi par valeurs des coefficients de transmission T<sub>i</sub> associés à chaque point Pi. Dans le cadre de la propagation d'une 25 onde ultrasonore, chaque coefficient de transmission  $T_{\mathbf{i}}$ est donné par la relation :

$$T_{i} = \frac{2\rho_{2}c_{2}\cos\beta_{i}}{\rho_{2}c_{2}\cos\beta_{i} + \rho_{1}c_{1}\left[1 - \frac{c_{2}^{2}}{c_{1}^{2}} + \frac{c_{2}^{2}}{c_{1}^{2}}\cos^{2}\beta_{i}\right]^{1/2}}$$
 [25]

Comme indiqué précédemment, les termes  $\cos\beta_i$  peuvent être déterminés en fonction des coordonnées respectives des sources  $S_i$  et du point M.

Pour estimer les valeurs de sources  $S_i$  de l'obstacle OBS, on applique la relation [22] en remplaçant toutefois la matrice de réflexion R par la matrice de transmission T:

$$\vec{\mathbf{v}} = [\mathbf{F}(\mathbf{P})]^{-1} \, \mathbf{T}[\mathbf{F}'(\mathbf{P})] \, \vec{\mathbf{v}}' \tag{26}$$

Dans le cadre de la propagation d'une onde ultrasonore, les coefficients des matrices R et T s'estiment pour chaque source  $S_i$  et pour chaque point  $P_i$ . En particulier, chaque coefficient  $T_{i,j}$  ou  $R_{i,j}$  de la matrice T ou de la matrice R (où i correspond à la ième ligne et j correspond à la jème colonne) s'exprime en fonction d'un angle  $\beta_{ij}$  entre une normale à la surface de l'obstacle au point  $P_i$  et une droite passant par le point  $P_i$  et par une source  $S_j$ . On peut écrire ainsi, de manière générale, les deux relations exprimant les valeurs des coefficients des matrices T et R par les relations respectives suivantes :

$$T_{i,j} = f_t (\cos \beta_{ij})$$
 [27]

$$R_{i,j} = f_r (\cos \beta_{ij})$$

[28]

où  $f_t$  est donné par la relation [25] et  $f_r$  est donné par la relation [24].

5

De façon plus générale, en référence aux figures 4A et 4B, on indique que, si l'on considère l'obstacle comme un matériau plein représentant un milieu M2 distinct d'un milieu M1 dans lequel se propageait initialement l'onde principale:

10

15

- pour une réflexion de l'onde principale sur l'obstacle en tant que milieu M2 (la surface de l'obstacle formant dioptre entre les milieux M1 et M2), les hémisphères HEM; sont orientés vers l'extérieur de l'obstacle (figure 4A); - pour une transmission de l'onde principale dans l'obstacle, les hémisphères HEM; sont orientés vers l'intérieur de l'obstacle (figure 4B).

20

25

30

On se réfère maintenant à la figure 5A pour décrire le cas d'un l'obstacle plan OBS de dimensions finies, excité par un élément rayonnant ER, incliné d'un angle prédéterminé par rapport à l'obstacle OBS. Comme indiqué précédemment, pour une onde ultrasonore, on prendra l'inclinaison de l'élément rayonnant pour calculer contribution de l'onde émise par l'élément rayonnant au Par ailleurs, de façon particulièrement point avantageuse, on maille une surface qui englobe la surface de l'obstacle (figure 5A). Pour une tranche de l'espace délimitée par l'élément rayonnant, d'une l'obstacle, d'autre part (figure 5A), on peut considérer trois types de sources :

- les sources S'i de l'élément rayonnant ER,
- des sources SO<sub>i</sub>, qui renvoient l'onde secondaire, par réflexion de l'obstacle OBS, en fonction d'un certain coefficient de réflexion R de l'obstacle; et
- des sources SSi, qui ne renvoient pas d'onde secondaire 5 et auxquelles un coefficient de réflexion nul peut être attribué si l'obstacle sépare deux milieux d'indices sont  $SS_{i}$ ces sources cas, identiques. Dans ce tranche "éteintes" dans la comme considérées l'espace précitée et ne sont pas prises en compte dans 10 les calculs de la grandeur physique au point M de la figure 5A. En revanche, ces sources SSi peuvent être principale de l'onde réflexion par actives d'indices milieux deux sépare l'obstacle OBS différents. 15

Par ailleurs, pour estimer les grandeurs scalaires ou vectorielles associées à un point M d'un demi-espace délimité par la surface englobant l'obstacle OBS (à droite de la figure 5B), on considère:

20

30

- les sources SO'i de l'obstacle, actives par transmission de l'onde principale, et
- les sources SS<sub>i</sub>, auxquelles on affecte maintenant un coefficient de transmission égal à 1 si l'obstacle sépare deux milieux de mêmes indices. Ces sources SS<sub>i</sub> se comportent finalement (aux angles d'incidence près) comme les sources S'<sub>i</sub> de l'élément rayonnant ER.

Les sources S'i de l'élément rayonnant peuvent alors être "éteintes" pour le calcul des grandeurs physiques dans ce demi-espace.



Pour calculer les valeurs  $\vec{v}'$  des sources  $S'_i$  de l'élément rayonnant (desquelles sont déduites les valeurs  $\vec{v}$  des sources de l'obstacle selon les relations [22] et [26]), on appliquera simplement des conditions aux limites aux points de la surface active de l'élément rayonnant ER. Par exemple, pour une propagation d'onde ultrasonore, on peut indiquer que les vitesses sonores aux points de la surface de l'élément rayonnant ER sont perpendiculaires à cette surface et de modules  $v_0$  égaux entre eux.

10

15

20

25

5

l'espace indique que manière générale, on De tridimensionnel peut être ainsi découpé par des interfaces délimitant des milieux de propriétés distinctes, chaque interface représentant un obstacle au sens de la présente invention. On calcule alors les grandeurs physiques dans chaque tranche de l'espace. Par exemple, dans le cadre de l'étude d'une hétérostructure (à plusieurs interfaces) on applique le procédé ci-avant pour des tranches successives deux interfaces : l'une en considérant l'espace représentant un "élément rayonnant" au sens des figures 4A et 5A, par exemple par transmission d'une onde reçue, et obstacle recevant 1'onde un l'autre représentant transmise. Avantageusement, on tient compte, pour chaque tranche de l'espace, des contributions de toutes les interfaces comme exprimé par les relations [10] et [22].

La simulation de la figure 5C correspond, pour une onde ultrasonore, à la situation des figures 5A et 5B en tenant compte :

o de la contribution de l'émission de l'onde principale par l'élément rayonnant ER;

- de la contribution de la réflexion de cette onde principale par l'obstacle ; et
- de la contribution de la transmission de l'onde principale par l'obstacle.

5

10

15

Les lignes de niveau de la figure 5C correspondent à différents paliers de pression acoustique. L'élément rayonnant ER est disposé à 10 mm de l'obstacle OBS et incliné de 20° par rapport à ce dernier. On remarque en particulier des franges d'interférences dans une zone entre l'obstacle OBS et l'élément rayonnant ER. Une telle simulation peut avantageusement indiquer une position idéale d'un capteur ultrasonore. Ces capteurs ultrasonores comportent habituellement un transducteur comme élément rayonnant actif et un détecteur pour mesurer les ondes ultrasonores reçues. La simulation de la figure 5C peut ainsi indiquer en outre la forme idéale d'un capteur ultrasonore, selon les applications souhaitées, pour une forme d'obstacle donnée.

20 -

- La simulation de la figure 5C a été effectuée grâce à un calcul matriciel programmé à l'aide du logiciel de calcul MATLAB©. Le nombre de mailles total choisi pour l'obstacle et pour l'élément rayonnant (ici, quelques centaines en tout) est alors optimisé:
  - d'une part, pour limiter la durée des calculs ; et
  - d'autre part, pour que la taille des mailles reste inférieure à une demie longueur d'onde, de manière à vérifier le critère de Rayleigh.

On indique toutefois que, comme les éléments à mailler dans la mise en œuvre du procédé selon l'invention sont simplement des surfaces, les temps de calcul sont bien moins longs que ceux nécessaires dans la mise en œuvre d'un procédé de calcul de type "par éléments finis".

La présente invention peut ainsi se manifester par la mise en œuvre d'une succession d'instructions d'un produit programme d'ordinateur stocké dans la mémoire d'un disque dur ou d'un support amovible et se déroulant comme suit :

- choix d'un pas de maillage notamment en fonction de la longueur d'onde de l'onde principale ;
- détermination des coordonnées des sources S<sub>i</sub> et/ou S'<sub>i</sub> et des points de contact P<sub>i</sub> et/ou P'<sub>i</sub>;
- choix d'un type d'onde en jeu et calcul des coefficients des matrices d'interaction appliquées aux points P<sub>i</sub> et/ou P'<sub>i</sub> par la mise en œuvre d'un logiciel de calcul matriciel;
- choix d'une loi de réflexion et/ou de transmission de la surface de l'obstacle et calcul des coefficients des matrices de réflexion et/ou de transmission;
  - calcul des valeurs des sources Si et/ou S'i ; et
  - calcul des grandeurs scalaires ou vectorielles en tout point de l'espace tridimensionnel.

25

5

10

A ce titre, la présente invention vise aussi un tel produit programme d'ordinateur.

Bien entendu, la présente invention ne se limite pas à la forme de réalisation décrite ci-avant à titre d'exemple ; elle s'étend à d'autres variantes.

Ainsi, on comprendra que, même si dans les figures commentées ci-avant on représente à la fois la surface d'un obstacle et la surface d'un élément rayonnant, la présente invention s'applique aussi à l'estimation de grandeurs physiques dans le cadre d'une onde interagissant avec un obstacle et émise en champ lointain. Dans ce contexte, il n'est pas nécessaire de matérialiser la surface d'un élément rayonnant à mailler et les relations [8] et [14] ci-avant suffisent à déterminer l'interaction entre cette onde et l'obstacle.

On a indiqué ci-avant des équations permettant de calculer les grandeurs scalaires ou vectorielles en un point M de l'espace, pour des ondes électromagnétiques, ou encore acoustiques. Bien entendu, ces grandeurs peuvent être estimées pour d'autres types d'ondes, notamment pour des ondes thermiques, des ondes électromagnétiques impliquant des antennes radiofréquences, ou autres.

Bien entendu, la présente invention ne se limite pas à une application au contrôle non destructif, mais à tout type d'application, notamment en imagerie médicale, par exemple pour l'étude de microsystèmes mettant en œuvre une microscopie acoustique à miroirs mobiles.

On a décrit ci-avant des interactions entre une onde et un obstacle unique. Bien entendu, la présente invention s'applique à une interaction avec plusieurs obstacles. A cet effet, il convient simplement de mailler les surfaces de ces obstacles et d'additionner leur contribution pour



l'estimation d'une grandeur vectorielle ou scalaire en un point quelconque de l'espace. De même, comme indiqué ciavant, la surface de l'obstacle OBS peut être plane, ou encore incurvée, ou encore de forme complexe quelconque.

5

d'une onde interagissant dans cadre Ainsi, le simulation dans l'espace, une plusieurs obstacles celle représentée sur la figure équivalente à permettrait de positionner des capteurs et/ou des éléments de la configuration rayonnants en fonction à notamment application la obstacles, pour une détermination de la position de hauts-parleurs dans un habitacle cloisonné, tel qu'un habitacle de véhicule automobile.

15

20

10

tridimensionnel découpé peut être une L'espace pluralité de régions, comme décrit ci-avant en référence aux figures 4A, 4B, 5A et 5B. Toutefois, pour qu'une surface de l'une desdites régions soit considérée comme un devenant onde principale, actif obstacle d'une émission d'une onde secondaire, l'incidence de l'onde sur cette surface doit préférentiellement principale rester inférieure ou égale à 90°.

#### Revendications

5

10

15

20

25

- 1. Procédé pour évaluer une grandeur physique associée à une interaction entre une onde et un obstacle, dans une région de l'espace tridimensionnel, dans lequel :
- a) on détermine, par maillage, une pluralité d'échantillons de surface  $(dS_i)$  dont une partie au moins représente la surface d'un obstacle recevant une onde principale et émettant, en réponse, une onde secondaire, et l'on attribue à chaque échantillon de surface au moins une source  $(S_i)$  émettant une onde élémentaire représentant une contribution à ladite onde secondaire,
- b) on forme un système matriciel comportant :
  - une matrice d'interaction (F(M)), inversible, appliquée à une région donnée (M) de l'espace et comportant un nombre de colonnes correspondant à un nombre total de sources,
  - une première matrice colonne dont chaque coefficient  $(v_i) \ \text{est associé} \ \text{à une source } (S_i) \ \text{et caractérise}$  l'onde élémentaire qu'elle émet,
  - et une seconde matrice colonne, obtenue par une multiplication de la première matrice colonne par la matrice d'interaction et dont les coefficients sont des valeurs d'une grandeur physique (V(M)) représentative de l'onde émise par l'ensemble des sources en ladite région donnée (M),
  - c) pour estimer les coefficients de la première matrice colonne  $(v_i)$ , on affecte des valeurs de grandeur physique choisies  $(V(P_i))$  à des points prédéterminés  $(P_i)$ , associés chacun à un échantillon de surface  $(dS_i)$ , lesdites valeurs choisies  $(V(P_i))$  étant rangées dans la seconde matrice

colonne, et l'on multiplie cette seconde matrice colonne par l'inverse de la matrice d'interaction appliquée auxdits points prédéterminés  $(P_i)$ ,

d) pour évaluer ladite grandeur physique (V(M)) représentant l'onde émise par l'ensemble des sources dans une région donnée (M) de l'espace tridimensionnel, on applique la matrice d'interaction à ladite région donnée (M) et on multiplie cette matrice d'interaction par la première matrice colonne comportant les coefficients estimés à l'étape c).

5

10

15

- 2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel, pour évaluer une grandeur physique représentative d'une interaction entre un élément rayonnant une onde principale et un obstacle recevant cette onde principale,
- à l'étape a), on détermine en outre, par maillage, une pluralité d'échantillons de surface (dS'<sub>i</sub>) représentant ensemble une surface active de l'élément rayonnant l'onde principale, et l'on attribue à chaque échantillon de la surface active au moins une source (S'<sub>i</sub>) émettant une onde élémentaire représentant une contribution à ladite onde principale,
- on applique en outre les étapes b), c) et d) aux échantillons de la surface active, et
- 25 on évalue ladite grandeur physique (V(M)) représentant l'interaction entre l'élément rayonnant et l'obstacle dans une région donnée (M) de l'espace tridimensionnel, en prenant en compte la contribution, en ladite région donnée (M), de l'onde principale émise par l'ensemble des sources de la surface active et la contribution de l'onde

secondaire émise par l'ensemble des sources de la surface de l'obstacle.

- 3. Procédé selon l'une des revendications 1 et 2, dans lequel chaque coefficient de la matrice d'interaction, appliquée à une région donnée de l'espace, est représentatif d'une interaction entre une source et ladite région donnée et la valeur de chaque coefficient est fonction d'une distance entre une source et ladite région donnée.
  - 4. Procédé selon l'une des revendications 1 à 3, dans lequel la matrice d'interaction appliquée, à l'étape c), aux dits points prédéterminés  $(P_i)$ , comporte un nombre de lignes correspondant à un nombre total de points prédéterminés  $(P_i)$ .

15

20

- 5. Procédé selon l'une des revendications 1 à 4, dans lequel la grandeur physique à évaluer est une grandeur scalaire  $(V(P_i))$  et, à l'étape a), on attribue une source unique à chaque échantillon de surface.
  - 6. Procédé selon la revendication 5, dans lequel la matrice d'interaction (F(M)) appliquée, à l'étape d), à une région de l'espace (M), comporte une ligne.
- 7. Procédé selon l'une des revendications 5 et 6, dans lequel chaque point prédéterminé  $(P_i)$  associé à un échantillon de surface  $(dS_i)$  correspond à un point de contact entre cet échantillon de surface  $(dS_i)$  et un hémisphère dont la surface est égale à la surface de cet

échantillon de surface, et de centre correspondant à une position de la source  $(S_i)$  qui est attribuée à cet échantillon de surface.

- 8. Procédé selon l'une des revendications 5 à 7, dans lequel:
  - l'onde principale est une onde électrique,

- les coefficients de la première matrice colonne sont des valeurs de charge électrique associées chacune à une source, et
- les coefficients de la seconde matrice colonne sont des valeurs de potentiel électrique.
- 9. Procédé selon l'une des revendications 5 à 7, dans 15 lequel:
  - l'onde principale est une onde magnétique,
  - les coefficients de la première matrice colonne sont des valeurs de flux magnétique associées chacune à une source, et
- 20 les coefficients de la seconde matrice colonne sont des valeurs de potentiel magnétique.
  - 10. Procédé selon l'une des revendications 5 à 7, dans lequel:
- 25 l'onde principale est une onde sonore,
  - les coefficients de la première matrice colonne sont des valeurs de vitesse de son associées chacune à une source, et
- les coefficients de la seconde matrice colonne sont des
   valeurs de pression acoustique.

11. Procédé selon l'une des revendications 1 à 4, dans lequel la grandeur physique à évaluer est une grandeur vectorielle  $(\underline{V}(P_i))$  exprimée par ses trois coordonnées dans l'espace tridimensionnel, et l'on attribue, à l'étape a), trois sources  $(SA_i, SB_i, SC_i)$  à chaque échantillon de surface (dSi).

- 12. Procédé selon la revendication 11, dans lequel la matrice d'interaction  $(F_{\nu}(M))$  appliquée, à l'étape d), à une région de l'espace (M), comporte une ligne pour chaque coordonnée (X,Y,Z) de l'espace.
  - 13. Procédé selon l'une des revendications 11 et 12, dans lequel:
- les trois sources attribuées à chaque échantillon de surface sont sensiblement dans un même plan et chaque point prédéterminé (Pi) associé à un échantillon de surface (dSi) correspond à un point de contact entre cet échantillon et un hémisphère dont la surface est égale à la surface de cet échantillon, et de centre correspondant à la position d'un barycentre des trois sources.
- 14. Procédé selon la revendication 13, dans lequel les trois sources d'un même échantillon de surface forment sensiblement un triangle équilatéral, et les triangles des échantillons de surface sont orientés sensiblement aléatoirement les uns par rapport aux autres.
- 30 15. Procédé selon l'une des revendications 11 à 14, dans lequel:

- l'onde principale est une onde électrique,
- les coefficients de la première matrice colonne sont des valeurs de charge électrique associées chacune à une source, et
- 5 les coefficients de la seconde matrice colonne sont des valeurs de coordonnées d'un champ électrique.
  - 16. Procédé selon l'une des revendications 11 à 14, dans lequel :
- 10 l'onde principale est une onde magnétique,
  - les coefficients de la première matrice colonne sont des valeurs de flux magnétique associées chacune à une source, et
- les coefficients de la seconde matrice colonne sont des valeurs de coordonnées d'un champ magnétique.
  - 17. Procédé selon l'une des revendications 11 à 14, dans lequel :
  - l'onde principale est une onde sonore,

25

- 20 les coefficients de la première matrice colonne sont des valeurs de vitesse de son associées chacune à une source, et
  - les coefficients de la seconde matrice colonne sont des valeurs de coordonnées d'une vitesse acoustique.
  - 18. Procédé selon l'une des revendications précédentes, dans lequel, pour estimer la contribution de l'onde secondaire en ladite région donnée à l'étape d), lesdites valeurs de grandeur physique  $(V(P_i))$  choisies à l'étape c) sont fonction d'un coefficient prédéterminé de réflexion

et/ou de transmission de l'onde principale par chaque échantillon de surface de l'obstacle.

- 19. Procédé selon la revendication 18, prise en combinaison avec l'une des revendications 6 et 12, dans lequel l'onde secondaire correspond à une réflexion de l'onde principale sur l'obstacle et l'hémisphère est orienté vers l'extérieur de l'obstacle.
- 20. Procédé selon la revendication 18, prise en combinaison avec l'une des revendications 6 et 12, dans lequel l'onde secondaire correspond à une transmission de l'onde principale dans l'obstacle et l'hémisphère est orienté vers l'intérieur de l'obstacle.
- 21. Procédé selon l'une des revendications 19 et 20, dans lequel, à l'étape c), on détermine les valeurs (v'i) associées aux sources (S'i) de l'élément rayonnant (ER) et on met en forme au moins :
- une première matrice d'interaction (F(P)) représentant la contribution des sources de l'obstacle aux points prédéterminés de la surface de l'obstacle  $(P_i)$ ,

- une seconde matrice d'interaction (F'(P)) représentant la contribution des sources de l'élément rayonnant aux points prédéterminés de la surface de l'obstacle  $(P_i)$ ,
- une matrice de réflexion (R) ou de transmission (T), dont les coefficients représentent des coefficients de réflexion ou de transmission en chaque point prédéterminé  $(P_i)$  de l'obstacle,
- 30 pour déterminer les valeurs des sources de l'obstacle  $(v_i)$  en fonction des valeurs des sources de l'élément rayonnant



- $(v'_i)$  et d'une multiplication des première et seconde matrices d'interaction et de la matrice de réflexion ou de transmission.
- 22. Procédé selon la revendication 21, dans lequel, à l'étape c), on détermine les valeurs (v'i) associées aux sources (S'i) de l'élément rayonnant (ER) en tenant compte de la réception de l'onde secondaire par l'élément rayonnant (ER) et en mettant en forme en outre :
- une troisième matrice d'interaction (F(P')) représentant la contribution des sources de l'obstacle aux points prédéterminés de la surface de l'élément rayonnant (P'i),

   et une quatrième matrice d'interaction (F'(P')) représentant la contribution des sources de l'élément rayonnant aux points prédéterminés de la surface de l'élément rayonnant (P'i).
  - 23. Procédé selon l'une des revendications 19 à 22, dans lequel la surface de l'obstacle correspond à une interface entre deux milieux distincts d'une hétérostructure.

20

25

- 24. Procédé selon l'une des revendications précédentes, dans lequel l'onde principale est une onde sonore et les coefficients de la matrice d'interaction sont chacun fonction d'un angle d'incidence d'une onde élémentaire issue d'une source en ladite région donnée (M).
- 25. Procédé selon l'une des revendications précédentes, dans lequel l'onde principale est une onde sonore et, à l'étape a), on choisit un nombre total d'échantillons de surface (dS<sub>i</sub>) sensiblement en fonction d'une longueur

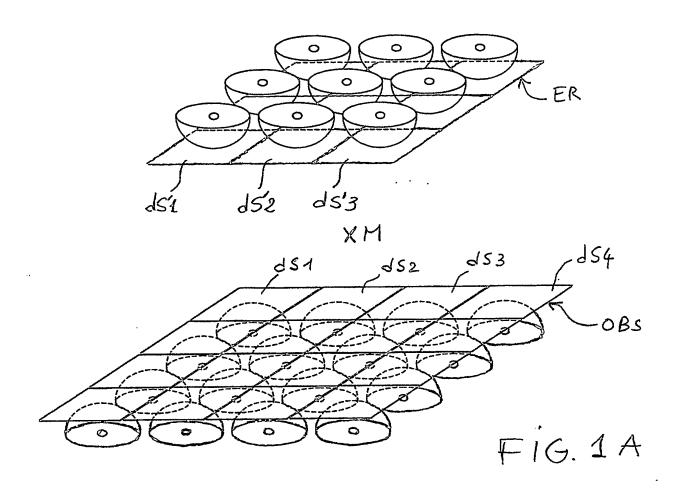
d'onde de l'onde sonore pour vérifier le critère de Rayleigh.

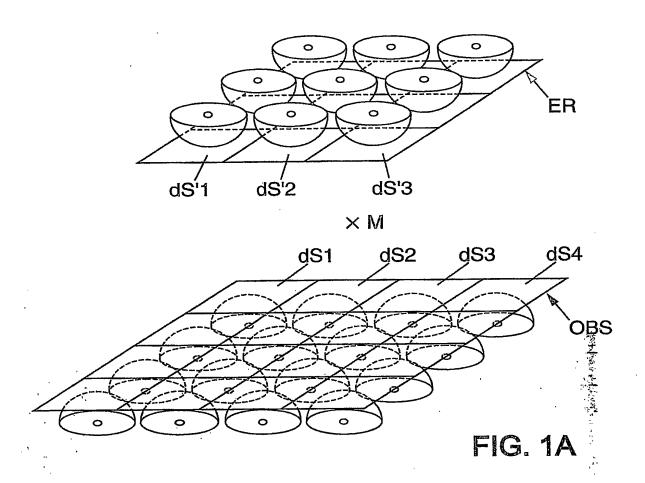
26. Procédé selon l'une des revendications précédentes, dans lequel on compare une pluralité de valeurs de la grandeur physique estimée à l'étape d), obtenues pour une pluralité de régions de l'espace, pour sélectionner une région candidate pour la disposition d'un élément rayonnant destiné à interagir avec l'obstacle.

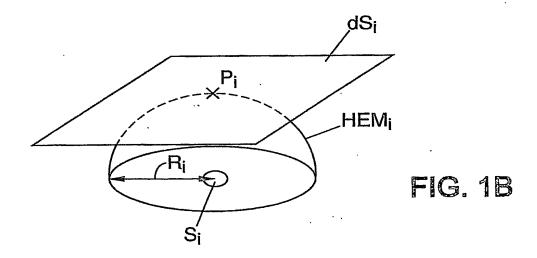
10

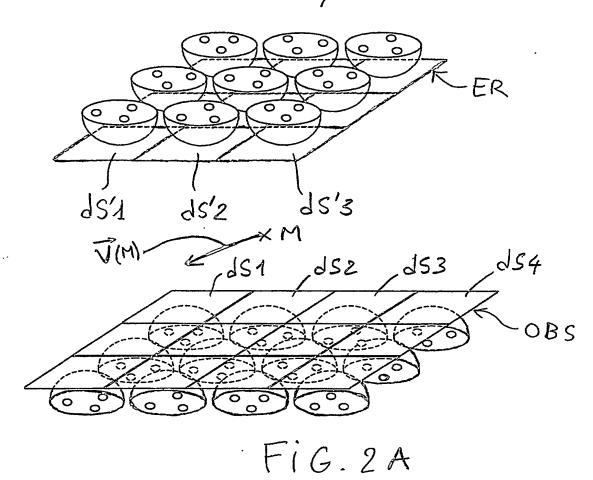
5

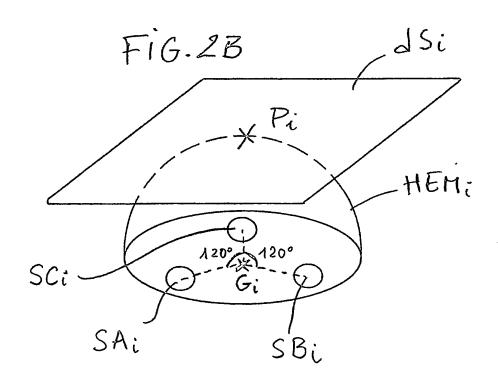
27. Procédé selon l'une des revendications 2 à 26, dans lequel l'élément rayonnant est un capteur, pour un contrôle non destructif, destiné à analyser un objet formant un obstacle de l'onde principale.











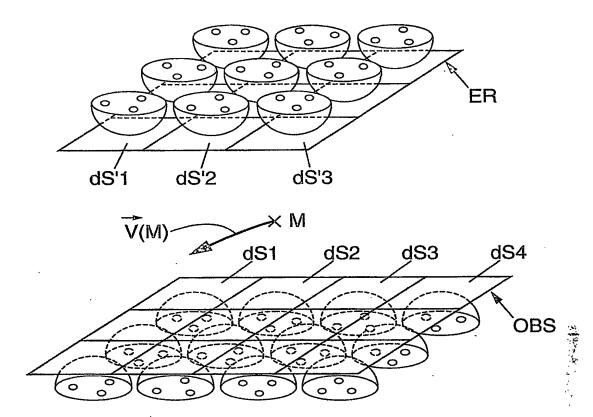


FIG. 2A

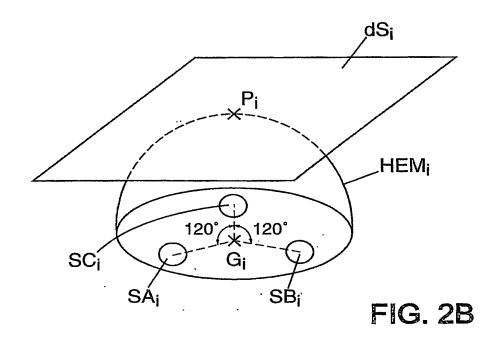
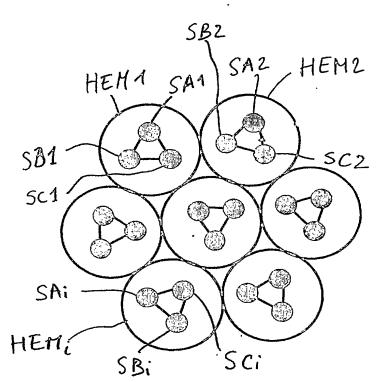


Fig.2C



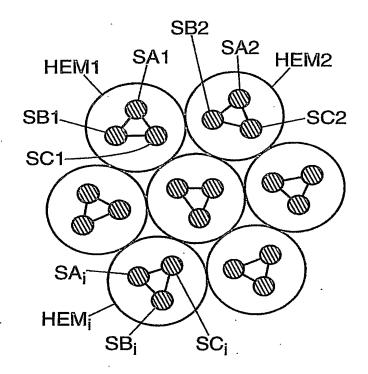
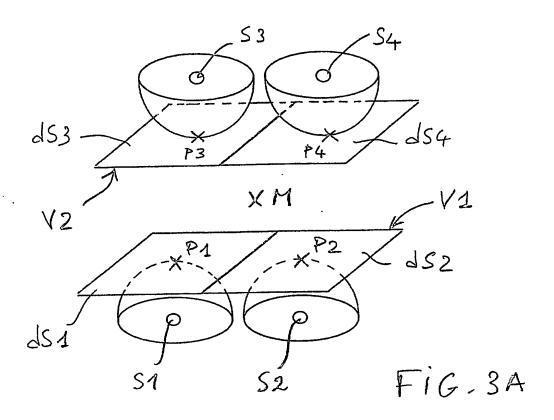
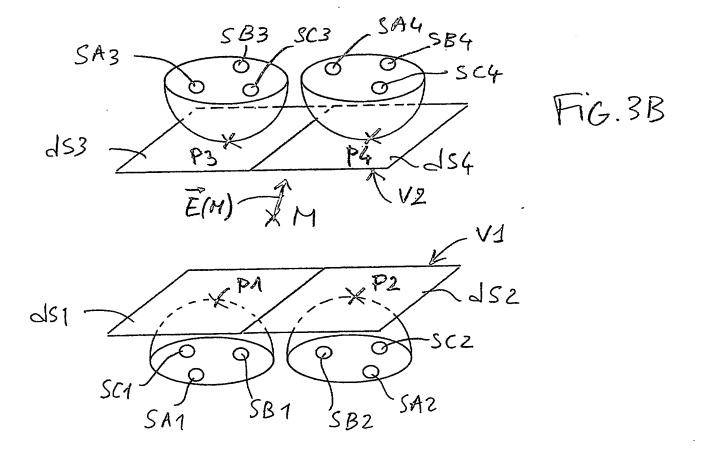
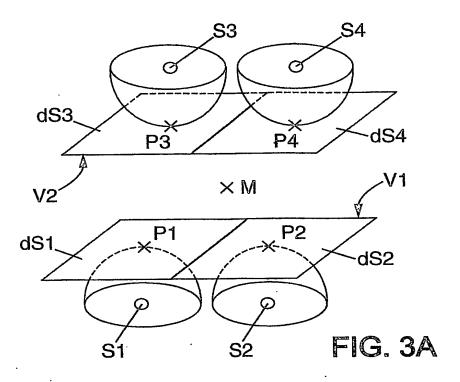
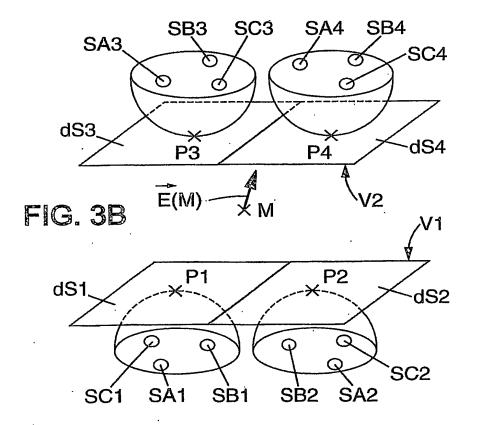


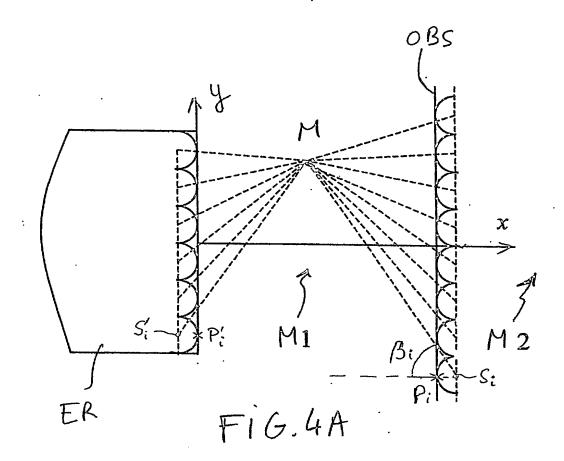
FIG. 2C

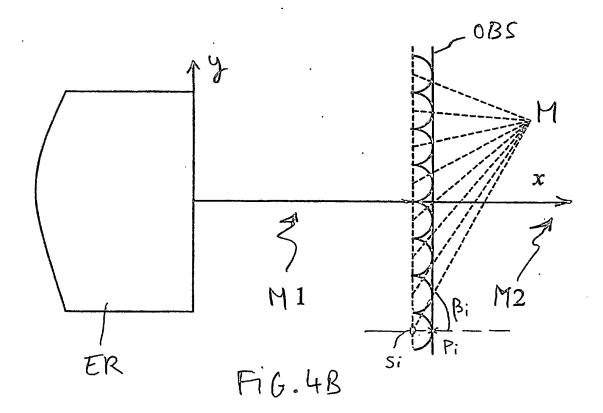












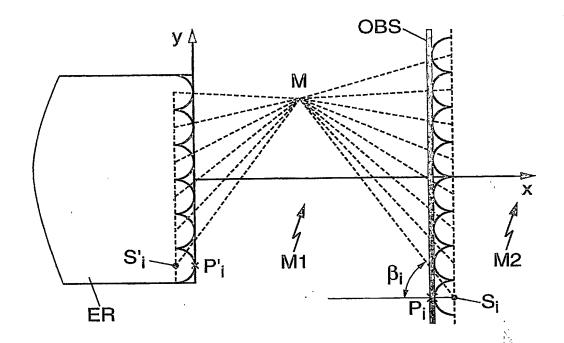


FIG. 4A

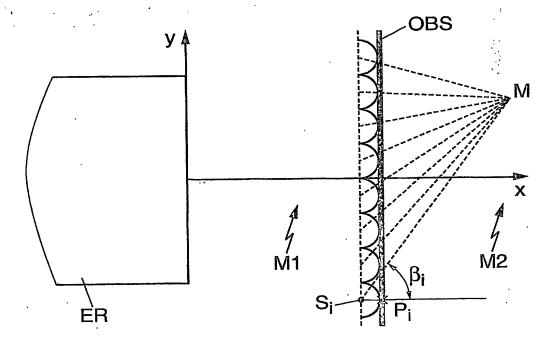


FIG. 4B



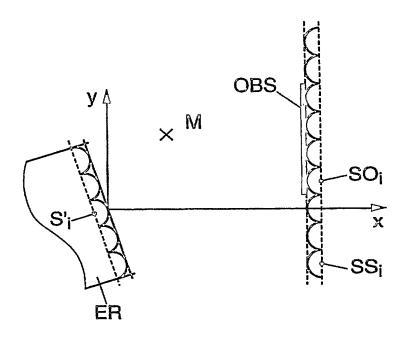


FIG. 5A

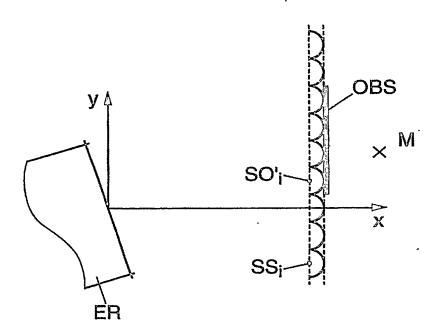


FIG. 5B

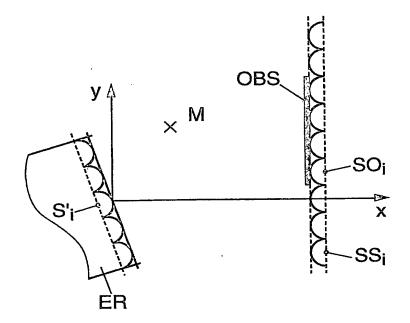


FIG. 5A

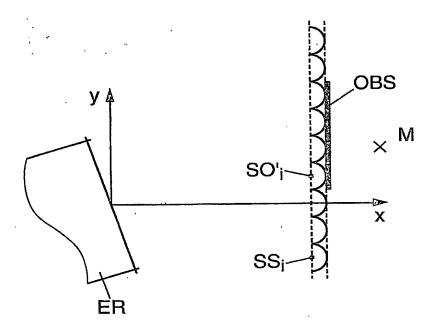


FIG. 5B

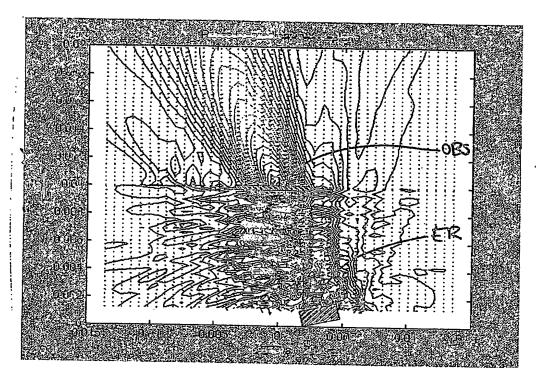


FiG.5C

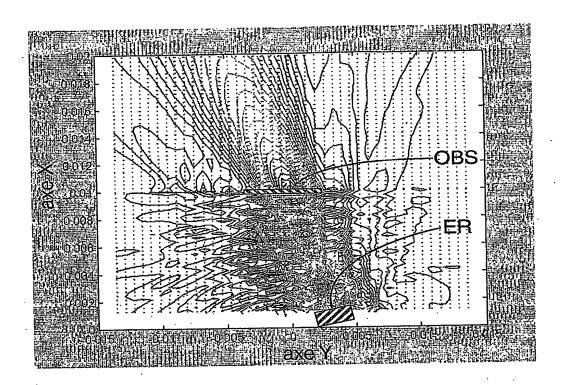
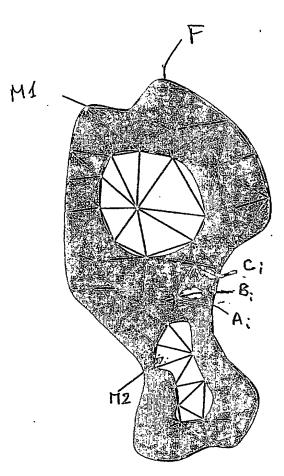


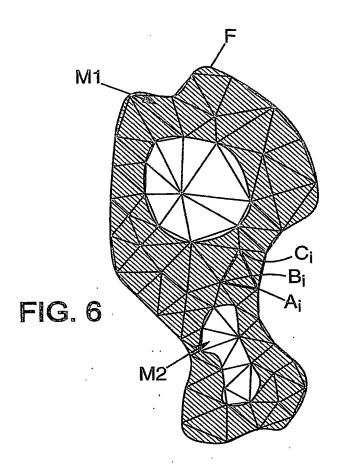
FIG. 5C

8/8



PiG.6







# BREVET D'INVENTION

## CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



#### **DÉPARTEMENT DES BREVETS**

26 bis, rue de Saint Pétersbourg

### DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Paga N° 1../1..

(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

5800 Paris Cedex 08 Hephone : 01 53 04 !	53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30		Cet imprime est à remplir lisiblement à l'encre noire	CB 113 W /26539	
Vos références pour ce dossier (facultatif)		АН/ЕМА-В			
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL			CE14108		
TITRE DE L'INV	ENTION (200 caractères ou	espaces maximum			
PROCEDE PO ONDE ET UN	UR EVALUER UNE GRA OBSTACLE.	ANDEUR PHY	SIQUE REPRESENTATIVE D'UNE INTERACTION ENT	RE UNE	
LE(S) DEMAN	DEUR(S):	<u> </u>			
ECOLE NORT UNIVERSITE UNIVERSITY	OF ARIZONA	CACHAN			
DESIGNE(NT) utilisez un for	EN TANT QU'INVENTEL mulaire identique et num	IR(S) : (Indique érotez chaque	z en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de tro page en indiquant le nombre total de pages).	ls inventeurs,	
Nom		PLACKO			
Prénoms		DOMINIQ	DOMINIQUE		
Adresse	Rue	21, ALLEI	21, ALLEE DE LA TOISON D'OR		
	Code postal et ville	94000	CRETEIL / FRANCE		
Société d'appartenance (facultatif)					
Nom		LIEBEAU	LIEBEAUX		
Prénoms		NICOLAS	NICOLAS		
Adresse	Rue	10, RUE C	10, RUE GUICHARD		
	Code postal et ville	94230	CACHAN / FRANCE		
Société d'appa	rtenance (facultatif)			·····	
Nom		KUNDU	KUNDU		
Prénoms		TRIBIKR	TRIBIKRAM		
Adresse	Rue	1201 EAS	1201 EAST CHULA VISTA RD.		
	Code postal et ville	85718	TUCSON / U S A		
Société d'appartenance (facultatif)					
DATE ET SIGI DU (DES) DEI OU DU MAND (Nom et qual Le 12 NOVE Bertrand LO	MANDEUR(S) DATAIRE ité du signataire) MBRE 2002		24		
CPI N° 94-0311			l .		

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.



FR0303323

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS
☑ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☑ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☑ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.